

○ 低周波電力増幅用

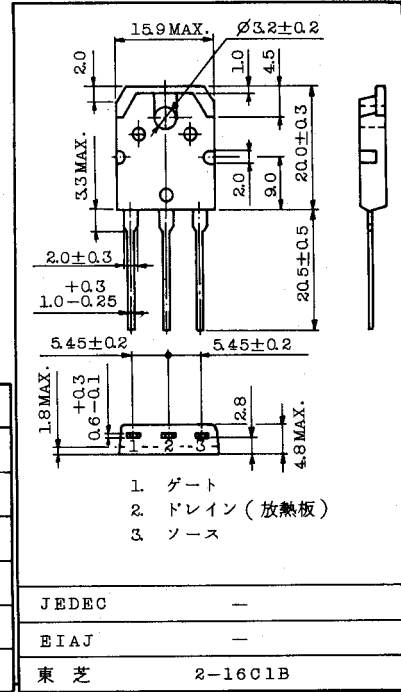
単位：mm

特長

- ・ 高耐圧です。 $V_{DSS}=160V$
- ・ 高順方向伝達アドミタンスです。 $|Y_{fs}|=2.0S$ (標準)
- ・ 2SJ115 とコンプリメンタリになります。

最大定格 ($T_a=25^\circ C$)

項目	記号	定格	単位
ドレイン・ソース間電圧	V_{DSS}	160	V
ゲート・ソース間電圧	V_{GSS}	± 20	V
ドレイン電流	I_D	8	A
許容損失 ($T_c=25^\circ C$)	P_D	100	W
チャンネル温度	T_{ch}	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	$-55 \sim 150$	$^\circ C$



電気的特性 ($T_a=25^\circ C$)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
ゲート漏れ電流	I_{GSS}	$V_{DS}=0, V_{GS}=\pm 20V$	—	—	± 1.0	μA
ドレイン・ソース間降伏電圧	$V_{(BR)DSS}$	$I_D=5mA, V_{GS}=0$	160	—	—	V
ゲート・ソース間しゅ断電流	$V_{GS(OFF)}$ (注)	$V_{DS}=10V, I_D=0.1A$	0.8	—	2.8	V
ドレイン・ソース間飽和電圧	$V_{DS(ON)}$	$I_D=5A, V_{GS}=10V$	—	2.5	7.0	V
順方向伝達アドミタンス	$ Y_{fs} $	$V_{DS}=10V, I_D=2A$	1.0	2.0	—	S
入力容量	C_{iss}	$V_{DS}=10V, V_{GS}=0, f=1MHz$	—	430	—	pF
出力容量	C_{oss}	$V_{DS}=10V, V_{GS}=0, f=1MHz$	—	260	—	pF
帰還容量	C_{rs}	$V_{DS}=10V, V_{GS}=0, f=1MHz$	—	80	—	pF

(注) $V_{GS(OFF)}$ 区分 O: 0.8~1.6, Y: 1.4~2.8

この製品は MOS 構造ですので取扱いの際には静電気にご注意ください。